06.5;05.1;15.1 Новый метод изображения микрообъектов в синхротронном излучении с использованием нанофокусировки и томографии

© В.Г. Кон¹, Т.С. Аргунова²

¹ Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия ² Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: argunova@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 3 августа 2022 г. В окончательной редакции 19 августа 2022 г. Принято к публикации 22 августа 2022 г.

Предложен новый метод исследования внутренней структуры микрообъектов с помощью синхротронного излучения, основанный на поглощении. Метод регистрирует интегральную интенсивность излучения после прохождения объекта, а локальность определяется фокусировкой пучка в линию нанометровой ширины с помощью преломляющей линзы. При этом фазовый контраст не используется, результат получается сразу, а двумерное изображение объекта, т.е. зависимость его толщины от поперечных координат, вычисляется методом томографии. Метод не нуждается в сложных математических расчетах и дает результат с весьма высокой точностью. Для иллюстрации выполнена симуляция эксперимента с подложкой карбида кремния для типичных значений остальных параметров.

Ключевые слова: синхротронное излучение, микрообъекты, нанофокусировка, томография, микропоры.

DOI: 10.21883/PJTF.2022.19.53593.19333

Развитие промышленных технологий получения объемных кристаллов карбида кремния (SiC) и сапфира (α -Al₂O₃) привело к улучшению их структурной однородности. Тем не менее широко используемые в электронике подложки из этих кристаллов могут содержать поры (SiC) или газовые включения (Al₂O₃), размеры которых уменьшились до субмикронной или нанометровой величины. Свойства наногетероструктур, выращиваемых методами эпитаксии, или графена, получаемого в результате термодеструкции поверхности SiC [1] или осаждения на сапфире [2], зависят от совершенства подложек. Это предъявляет высокие требования к методам диагностики. При этом рентгеновские методы играют важную роль, устраняя разрыв между оптической и электронной микроскопией.

С помощью синхротронного излучения (СИ) можно изучать внутреннюю структуру объектов с микронными размерами. Однако простая схема эксперимента "на просвет", основанная на учете поглощения при прохождении лучей через объект, для микрообъектов неприменима, поскольку наряду с поглощением возникает фазовый контраст, т. е. локальное изменение интенсивности излучения из-за разницы фаз лучей, прошедших через объект и мимо него [3]. Это изменение не влияет на интегральную интенсивность и в среднем равно нулю. Для больших размеров объекта даже в когерентном излучении фазовый контраст усредняется, так как период осцилляций весьма мал, а очень высокое разрешение детектора не требуется.

При уменьшении размеров объекта необходимы либо сильное увеличение изображения, т.е. рентгеновская микроскопия, либо очень высокое разрешение детектора.

При этом роль поглощения уменьшается, а фазовый контраст имеет относительно большой период и хорошо виден. Для наблюдения фазового контраста высокая когерентность не требуется, но она нужна для адекватного решения обратной задачи. Дело в том, что фазовый контраст не позволяет сразу получить функцию t(x, y) толщины объекта под пучком в зависимости от координат в плоскости, поперечной направлению пучка, которую будем называть изображением объекта. Необходимы методы вычисления t(x, y) из измеряемой координатным детектором интенсивности I(x, y). При наличии как поглощения, так и фазового контраста обратная задача решается неточно.

Обычно при ее решении поглощением пренебрегают, так как изменения интенсивности при фазовом контрасте больше изменений из-за поглощения. Но при этом необходим жесткий контроль степени когерентности. Это касается всех методов, включая как рентгеновскую микроскопию, так и методы когерентного дифракционного изображения и птайкографии [4]. Контроль степени когерентности представляет собой сложную задачу, так как когерентность может быть испорчена многими факторами (не только физическим размером источника). Важным инструментом таких исследований является координатный детектор с высоким разрешением (обычно около 1 μ m), который не всем доступен.

В настоящей работе предлагается принципиально другой метод изображения микрообъектов, который основан только на поглощении. Он позволяет получить функцию t(x, y) без решения обратной задачи фазового контраста и при любой степени частичной когерентности. Избавиться от фазового контраста позволяет измере-



Рис. 1. Схема эксперимента. 1 — составная преломляющая линза, 2 — образец, 3 — детектор, z_s — расстояние от источника до линзы, L — длина линзы, z_f — фокусное расстояние, z_1 — расстояние от образца до детектора. Пучок СИ двигается по образцу вертикально при каждом угле поворота образца вокруг оси Z.

ние интегральной интенсивности излучения с помощью детектора, который суммирует все прошедшие фотоны после образца. При этом фазовый контраст усредняется и изменения интенсивности определяются только поглощением.

Локальность информации на объекте формируется с помощью нанофокусировки пучка при использовании планарной составной преломляющей линзы (СПЛ) [5]. В настоящее время технологии изготовления СПЛ стали более сложными, а качество самих СПЛ сильно выросло. В том числе появились планарные нанофокусирующие СПЛ, способные фокусировать пучок в размер не более 20 nm [6]. Разработаны также онлайнпрограммы, которые вычисляют все параметры пучка при фокусировке такими СПЛ [7].

Схема эксперимента для нового метода показана на рис. 1. Пучок СИ после монохроматора (не показан) фокусируется планарной СПЛ в вертикальном направлении, так как вертикальный размер источника СИ меньше горизонтального. Образец, например кристалл SiC, содержащий поры микронного размера разной формы, помещается на фокусном расстоянии z_f от СПЛ. Детектор устанавливается на произвольном расстоянии z_1 и измеряет все излучение, которое в него попадает. Планарная СПЛ фокусирует пучок только вдоль оси Y. Вдоль оси X локальности нет, и пучок ограничивается только щелью.

Планарная СПЛ способна формировать линейный узкий пучок с длиной до $70 \,\mu$ m. Щель может ограничивать его до меньших значений. Таким способом получается одна точка зависимости I(y), интегральной по координате x. Все точки можно получить, двигая СПЛ вдоль оси Y с малым шагом. Шаг такого движения выбирается исходя из точности изображения, которую необходимо получить. В настоящее время имеются пьезоподвижки, способные двигать образец с очень малым шагом (всего несколько нанометров). Описанный выше способ позволяет получить зависимость от координаты y для интегральной по координате x интенсивности. На данный момент СПЛ, которые фокусируют пучок в круг нанометрового диаметра, не существуют, и пока неясно, как это можно сделать в принципе.

Получить зависимость I(x, y) можно при использовании метода томографии. Для этого необходимо вращать образец вокруг оси Z, что позволяет получить двумерный набор данных $I(y, \varphi)$ (где φ — угол вращения), т. е. синограмму. Это условно показано на рис. 1. Вращать нужно на углы в интервале от 0 до 180° с постоянным шагом и при каждом угловом положении образца двигать сфокусированный пучок в вертикальном направлении. Затем с помощью программы томографии синограмму можно превратить в томограмму, т. е. зависимость I(x, y). Искомая зависимость t(x, y) получается логарифмированием и умножением на постоянный коэффициент.

В этом методе нет неоднозначных математических расчетов. Разрешение метода определяется размером пучка в фокусе линзы. И в этом месте когерентность СИ все же необходима, так как фокусировка — это частный случай фазового контраста. А размер пучка в фокусе определяется не только СПЛ, но и поперечным размером источника СИ. Однако когерентность может быть частичной. Это просто уменьшает разрешение, но не приводит к существенным ошибкам.

Отличие метода от стандартной томографии состоит в том, что здесь нужно логарифмировать не синограмму, а томограмму. Мы получаем интегральную интенсивность по поперечной координате x. Стандартная томография сразу дает функцию t(x, y), а в данном методе мы получаем функцию t(x, y). И это определяет особенность метода. Если использовать алгоритм FBP (filtered back projection) [8], то в нем вычисляется преобразование Фурье на конечной области. При этом предполагается, что за пределами этой области функция равна нулю, то же самое должно быть на ее границах.

Но функция I(x, y) не может быть равна нулю. Если ее нормировать на единицу за пределами объекта, то она будет равна единице. При этом на границе области получается скачок, который приводит к сильному артефакту. Он состоит в том, что фон, на котором показывается объект, т.е. функция t(x, y), близок к нулю только в



Рис. 2. Четыре разные функции в плоскости (X, Y), поперечной пучку СИ, в квадратной области с линейным размером 25.6 μ m. a — функция t(x, y) исходной толщины образца, b — синограмма, c — томограмма, d — вычисленная функция t(x, y). Все функции показаны в интервале от минимального до максимального значений, который приведен к интервалу (0, 1). Реальные минимум и максимум для каждой функции указаны в тексте. Ось Y идет вертикально.

центре области, а по мере приближения к границам он очень сильно возрастает. Исправить ситуацию можно следующим образом. При нормировке интенсивности за пределами объекта на единицу нужно вычесть единицу в каждой точке объекта при расчете синограммы, т.е. вычесть из каждого значения синограммы число точек расчетной сетки, а затем добавить эту единицу в каждую точку томограммы. Это позволяет избавиться от артефакта.

Поскольку в данном методе контраст определяется только поглощением, для микрообъектов он будет слабым, и лучше подходит мягкое излучение с малой энергией фотонов. С другой стороны, необходимо большое число фотонов, чтобы контраст не портился дробовым шумом, относительная величина которого равна единице, деленной на квадратный корень из числа фотонов, т.е. при изучении пор в кристаллах нужно стараться иметь образцы с меньшей толщиной.

В качестве иллюстрации метода мы провели компьютерную симуляцию эксперимента для следующих параметров: энергия фотонов 6.2 keV, вертикальный размер источника 100 μ m, расстояние от источника до СПЛ $z_s = 14$ m, планарная СПЛ на поверхности кремния имеет десять элементов с апертурой $50\,\mu$ m, радиусом кривизны $6.25\,\mu$ m, толщиной материала между параболическими поверхностями $2\,\mu$ m. Расчет по онлайнпрограмме [7] для указанных условий дает для гауссовой кривой интенсивности в фокусе полуширину $0.332\,\mu$ m, в то время как для точечного источника полуширина равна $0.282\,\mu$ m, т.е. размер источника не очень сильно увеличивает полуширину пучка в фокусе. Фокусное расстояние равно $z_f = 2.39$ cm.

Образец представляет собой пластинку кристалла SiC, в которой находятся поры различной формы и размера. На рис. 2, *а* показана функция t(x, y) для таких объектов. Там, где они отсутствуют, t = 0 (черный цвет). Это минимум толщины пор. Максимум равен $t_{max} = 8 \mu m$ (белый цвет). Размер расчетной области равен 25.6 μm . Использовалась сетка точек с шагом 0.1 μm и числом точек 256. Шаг сетки соответствует шагу вертикального сканирования сфокусированного пучка через образец. На рисунке показаны две сферы с диаметрами 4 и 8 μm и эллипсоид с диаметрами 2, 12, 8 μm по осям X, Y, Z соответственно.

Эти данные использовались для расчета синограммы, показанной на рис. 2, b. Здесь горизонтальный размер снова равен 25.6 µm, а вертикальный размер соответствует интервалу углов от -90 до 90°, который был рассчитан с шагом 1°. Функция t(x, y) использовалась для расчета $I(x, y) = \exp[Mt(x, y)]$, где $M = 0.02998 \,\mu \text{m}^{-1}$. Наличие пустоты в материале приводит к увеличению интенсивности, которая при отсутствии пустоты нормируется на единицу. Функция I(x, y) суммировалась по всем точкам оси Х при разных значениях угла φ поворота образца вокруг оси Z, что соответствовало синограмме $I(y, \phi)$. Учет размера пучка в фокусе выполнялся путем расчета свертки у-зависимости при каждом угле с функцией Гаусса, полуширина которой равна 0.332 µm, как указано выше. Кроме того, в каждой точке у-зависимости вычиталось число точек (256), чтобы получить минимум, равный нулю. В результате оказалось, что минимум на синограмме равен нулю с высокой точностью, а максимум равен 24.5 µm.

Синограмма симулирует экспериментальные данные. Расчет томограммы выполнялся по собственной программе. После расчета в каждую точку добавлялась единица. Результат показан на рис. 2, *с*. Контраст, как и прежде, рисуется от минимума (черный) до максимума (белый), но минимум равен 1.006, а максимум — 1.277. Контраст как отношение разности к сумме указанных значений равен 0.12, что не так уж и мало. Зависимость t(x, y) получаем после логарифмирования томограммы и деления на *M*. Она показана на рис. 2, *d*. Визуально изображения на рис. 2, *a* и *d* почти не различаются, но это связано с тем, что разрешение весьма невелико.

Первое отличие можно получить по минимальному и максимальному значениям на рис. 2, *d*. Они равны 0.19 и 8.15 μ m соответственно. На рис. 3 показано сравнение исходной кривой t(x) на высоте $y = 12.2 \,\mu$ m и вычисленной из синограммы с учетом размера пучка.



Рис. 3. Детальное сравнение исходной (красная кривая с нулевым фоном) и вычисленной (черная кривая с фоном выше нуля) функций t(x, y) на оси X при $y = 12.2 \, \mu$ m.

Видно, что метод в целом хорошо описывает объекты, но не способен описать резкие изменения толщины на их границах, а также сам факт их отсутствия. Фон хотя и не очень высокий, но все же не равен нулю. Для повышения точности нужны еще более узкие пучки.

Финансирование работы

Работа В.Г. Кона выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (проект 075-15-2021-1362), а также частично за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований 19-29-12043 мк. Работа Т.С. Аргуновой выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (проект 075-15-2021-1349).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- A.A. Lebedev, S.Yu. Davydov, I.A. Eliseyev, A.D. Roenkov, O. Avdeev, S.P. Lebedev, Y. Makarov, M. Puzyk, S. Klotchenko, A.S. Usikov, Materials, 14 (3), 590 (2021). DOI: 10.3390/ma.14030590
- [2] J. Shan, J. Sun, Z. Liu, ChemNanoMat, 7 (5), 515 (2021). DOI: 10.1002/cnma.202100079
- [3] A. Snigirev, I. Snigireva, V. Kohn, S. Kuznetsov, I. Schelokov, Rev. Sci. Instrum., 66 (12), 5486 (1995).
 DOI: 10.1063/1.1146073
- [4] J.-Y. Buffiere, J. Baruchel, in Synchrotron radiation: basics, methods and applications, ed. by S. Mobilio, F. Boscherini, C. Meneghini (Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-N.Y.-Dordrecht-London, 2015), p. 389. DOI: 10.1007/978-3-642-55315-8
- [5] A. Snigirev, I. Snigireva, V. Kohn, V. Yunkin, S. Kuznetsov, M.V. Grigoriev, T. Roth, G. Vaughan, C. Detlefs, Phys. Rev. Lett., 103 (6), 064801 (2009).
 DOI: 10.1103/PhysRevLett.103.064801
- [6] V.G. Kohn, M.S. Folomeshkin, J. Synchrotron Rad., 28 (2), 419 (2021). DOI: 10.1107/S1600577520016495

- [7] http://kohnvict.ucoz.ru/jsp/1-crlpar.htm
- [8] A.C. Kak, M. Slaney, Principles of computerized tomographic imaging (IEEE Press, N.Y., 1988).